PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

54-040236

(43) Date of publication of application: 29.03.1979

(51)Int.CI.

C23C 3/02

(21)Application number: 52-106446

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

YUBI HIROSHI (72)Inventor:

(54) PLATING PROCESS

(57)Abstract:

PURPOSE: To easily form a plated film of high adhesion strength by coating the surface of a layer to be plated with a silance coupling agent having hydrophilic chelate-forming active functional group in its molecule, followed by electroless plating. CONSTITUTION: A layer such as glass to be plated is dipped for several Wseveral tens sec in a soln. of a silance coupling agent of formula NH2-R-Si(OR')3 (where R is 3W5 C and the atomic ratio of N:C-1:3 or more) having-NH2 at the end, whereby the agent release R'OH to provide the highly hydrophilic active properties of the functional group-NH2 to the oxide surface. So, adhesion of Pd particles or the like to be allowed to adhere in plating pretreatment is facilitated and Pd forms chelate. Accordingly, a film formed by next electroless plating is allowed to firmly adhere to the oxide through the coupling agent.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

This Page Blank (Uspto)

即日本国特許庁(JP) ① 特 許 出 願 公 告

⑫特 報(B2) 昭59-52701 公

到Int.Cl.3

識別記号

庁内整理番号

2040公告 昭和59年(1984)12月21日

3/02 17/10 101

7011-4K 8017-4G

発明の数 1

(全7頁)

1

匈メツキ方法

②特 昭52-106446 頤

22出 頭 昭52(1977)9月5日

69公 開 昭54-40236

③昭54(1979)3月29日

②発 明 由尾 啓 者

東京都目黒区五本木1の38の1

创出 ソニー株式会社 餌

②代 理 弁理士 土屋·勝 外3名 人

の特許請求の範囲

1 親水性を有しかつキレートを形成し易い活性 15 プリング剤を被メツキ層の少なくとも表面に存在 官能基を分子中に有するシランカツプリング剤を 被メツキ層の少なくとも表面に存在させ、この状 態で前記被メツキ層の前記表面に無電解メツキを 施すようにしたメツキ方法。

発明の詳細な説明

本発明はメツキ方法、特にメツキされにくいガ ラス等の被メツキ体に無電解メツキを施す方法に 関するものである。

光学的に記録情報を検出するビデオデイスクが 最近注目されているが、ビデオデイスクの製造過 25 程でガラス板の表面に無電解メツキを施したり、 或いはガラス板の表面に所定パターンに形成した 感光性樹脂(フオトレジスト)層の表面に無電解 メツキを施す必要がある。

ところが、ガラス板の表面は極めて平坦であ30 り、また水の吸着によつて親水性となつているの で、メツキ膜の密着力が低くて容易に剝れたり、 親水性の悪いフォトレジストがガラス板に密着し 難いという問題がある。このため、密着力を上げ るための前処理として、ガラス板の表面を化学 35 的、電気的又は機械的に粗面化する方法や、ガラ ス板の表面に触媒を蒸着又はスパツタリングして

気相メツキを付ける方法がある。しかしながら、 前者の粗面化する方法においては、ビデオディス クの原盤製作の最終段階において記録層がSiOa や金属酸化物で形成されている場合には、記録層 5 の精度が低下してS/N比の劣化が生じることを 考えれば通常のエツチングによる前処理法は採用 できないし、また他の処理で粗面化したとしても S/N比や美観の劣化が生じて非常に都合が悪 い。また後者の気相メツキ法では、特別な装置を 東京都品川区北品川6丁目7番3510 必要とし、ランニングコストが高くなるという欠 点がある。

2

本発明は上述の如き欠陥を是正すべく発明され たものであつて、親水性を有しかつキレートを形 成し易い活性官能基を分子中に有するシランカツ させ、この状態で前記被メツキ層の前記表面に無 電解メツキを施すようにしたメツキ方法に係るも のである。この方法によつて、メッキ膜の密着力 を向上させることができると共に、エツチング等 20 を行なうことなく、然も特別な装置も用いること なく、密着力の高いメツキ膜を容易に形成するこ とが可能となり、特にビデオデイスクにおける記 録精度(S/N比)を高く維持することができ る。

本発明による方法においては、上述のシランカ ツプリング剤として下記のものが挙げられる。

 $CH_2 = CH - S_i CI_3 : UCC 社製のA - 150、信$ 越化学社製のKA103

 $CH_2 = CH - S_1(OC_2H_5)_3$:信越化学社製の 48% KBE 1003 to the control of the state

 $CH_2 = CH - S_i (OCOCH_8)_3 : UCC社製のA-$

 $CH_2 = CH - S_1 (OCH_2 CH_2 OCH_3)_3 : U C C$ 社製のA-172、信越化学社製のKBC1003 $CH_0 = C(CH_3)COO(CH_2)_3 - S_1(OCH_3)_3$: UCC社製のA-174、信越化学社製の

KBM 503

:信 $CH_{2} - CH - (CH_{2})_{3} - O - S_{1} (OCH_{3})_{3}$ 越化学社製のKBM 403

 $CH_2 - CH - (CH_2)_3 - O - S_i (OC_2H_5)_3$: UCC 社製のA-187

:パツカー・ヒエミー社製の GF81

$$O \longrightarrow -(CH_2)_3 - S_1(OCH_3)_3 : UCC$$

社製のA-186、信越化学社製のKBM303 H, N-(CH₂)₃-S_i(OC₂H₅)₃: UCC社及 び日本ユニカー社製のA-1100

 $H_2 N - (CH_2)_2 - NH - (CH_2)_3 - S_1 (OCH_3)_3$ 20 4. : UCC社製の Y-1120、信越化学社製の KBM603、ダウ・コーニング社製の Z 6020、パツカー・ヒエミー社製のGF

(OCH₃)₂

:信越化学社製の KBM602

 $H_2 N - (CH_2)_2 - O - (CH_2)_3 - S_i (CH_3)$ (OCH₂ CH₂ NH₂)₂

: パツカー・ヒエミー社製のGF90

 $(HOCH_2 CH_2)_2 N(CH_2)_3 - S_i (OCH_3)_3$: UCC 社製の Y - 2967

Cl-(CH₂)₃-S_i(OCH₃)₃: UCC社製のY

HS(CH,) S;(OCH3) : UCC社製のA-

I(CH₂)。S_i(OCH₃)。:ダウ・阿は全学ググ社 製の XZ85021

 $C_6 H_5 - S_1 (OC_2 H_5)_3 : UCC 社製のA - 153$ ポリアミノトリメトキシシラン:ダウ・コーニン グ社製の Z 6050

以上挙げたシランカツプリング剤のうち、シラ

ノール基とは反対側の末端に、−NH₂や−OH基 等の親水性の高い官能基を有するものが望まし く、例えばA - 1100、Y - 1120、Z6020、 KBM603, GF91, KBM602, GF90, Y-29675' 5 好ましい。末端に−NH₂基や−OH基が存在すれ ば、これらの官能基が触媒金属である例えばPd と配位化合物(キレート)を形成し易く、これに よつてメツキ膜の密着力を高めるよう作用する。 このキレート形成には例えばN原子が作用してい 10 るので、上述の-NH2も含めて官能基は第1級 ~第3級アミン又はこれらの塩、或いはアミド又 はイミノ基であつてもよい。

また上述のシランカツプリング剤は、例えば末 端に−NH₂を有するものは次の一般式

 NH_2-R-Si (OR') s.

で表わされる。この一般式においては、Rの炭素 数は3~5であるのが適度の疎水性を示す点で望 ましく、またNとCの原子比はN:C=1:3以 上であるのがよく、1:5以上であるのが更によ

また本発明による方法においては、上述の被メ ツキ層は、メツキの付きにくいガラス、金属、他 の無機酸化物、セラミツクからなつていてよく、 従来のように粗面化処理する必要はなく、後述の $H_2N-(CH_2)_2-NH-(CH_2)_3-S_1(CH_3)$ 25 ようにシランカツプリング剤の溶液に単に浸漬す るのみで、メツキの前処理が施されるものであ る。なおその浸漬時間は、通常、数秒~十数秒と 極めて短時間でよい。

次に、本発明による方法の原理を説明する。

本発明で使用するシランカツプリング剤は、シ ラノール基ーSi (OR') 。の末端が酸化物表面の 水酸基-OHと化学的に結合して配列し、他方こ のためにR'OHを放出する。この結果、酸化物表 面がシランカツプリング剤の他の末端基(例えば 35 -NH₂、-OH) の性質を示すようになる。この 末端基(官能基)は前述したように親水性が高く て活性であるために、メツキ前処理で付着させる 例えばPd粒子が付き易くなり、然もPdが配位結 合してキレートを形成すると考えられるので、シ 40 ランカツプリング剤は酸化物表面及びPd粒子と もに結合した状態で存在することになる。従つ て、次の無電解メツキによるメツキ膜は、シラン カツプリング剤を介して酸化物(被メツキ体)の 表面に強固に密着し、密着力が高くなるものと考

えられる。また、シランカツプリング剤のシラノ ール基とは反対側のNH₂-R-について言え ば、この部分はRの存在によつて全体として疎水 性になつている。従つて、後述するように、ガラ ス板上に塗布したフォトレジスト中にシランカツ 5 つた。 プリング剤を混入させておけば、フオトレジスト とのなじみが良くて結合し易く、このためにシラ ンカツプリング剤を介してフオトレジストがガラ ス板に強固に密着すると共に、フォトレジスト表 面にもシランカツプリング剤が存在することによ 10 実験例 5 つてフオトレジスト表面に対するメツキ膜の付き も良くなる。

次に本発明を更に詳細に説明するために、各種 の実施例1~6を述べ、次いで添付図面に基いて 本発明の実施例を述べる。

実験例 1

フロートガラス (現在最も平坦な面で凹凸0.01 μ 以下)を中性の洗浄剤で洗浄後、シランカツプ リング剤水溶液 (日本ユニカー社製のA-1100: 常温、0,5%)に10~30秒浸漬した後、直ちに水20 洗し、通常の化学メツキ(無電解メツキ)処理を 行つた。例えば、第1活性化(シツブレー社製の キヤタリスト)、第2活性化((シツプレー社製の アクセレータ)、化学メツキの順であつた。こう して作つたメツキ膜は、電気メツキに充分耐え得25 社のAZ-1350中に対して日本ユニカー社製のA る厚さ(0.2~0.5μ)であり、セロテープテスト の結果、全く剝れなかつた。また無電解メツキ膜 のノイズレベルを測定したところ、-75~-80dBMであつた。なおこの実験において、シラ ンカツプリング剤による前処理を除いたプロセス 30 で同様に実験したところ、メツキ膜の被覆率は~ 5%であり、セロテープテストにより100%剝れ てしまつた。

実験例 2

フロートガラス上にSiO2を蒸着したものをサ35 ンプルとし、洗浄後に実験例1と同様にメツキ膜 を形成した。この場合も、セロテープテストの結 果メット膜は剝れなかつた。なおジランカップリ ング剤による前処理をしない場合には、上述と同 様にメツキ膜の被覆率は~5%であり、セロテー40 入せしめ、これによつてシランカツプリング剤を プテストにより100%剝れてしまつた。

実験例:3

99.9%のアルミナの板に、洗浄後、実験例1と 同様にメツキ膜を形成したが、セロテープテスト

の結果、メツキ膜は剝れなかつた。なおシランカ ツプリング処理を除いたプロセスで同様にメッキ したところ、やはりメツキ膜の被覆率は~5%で あり、セロテープテストにより100%剝れてしま

実験例 4

- フロートガラスを用い、シランカツプリング剤 として、日本ユニカー社製のA-1120、1130でも 効果は同様であつた。

ガラス上に、少量のA-1100を混入したポリ塩・ 化ビニルのテトラヒドロフラン溶液を塗布し、完 ・全に乾燥後、洗浄し、第1活性化に続いて第2活 性化、化学メツキを行つた。A-1100を混入しな 15 いサンプルの場合と比較して強い密着力が得られ た。

実施例 6

シランカツプリング剤は、フオトレジストのガ ラス、SiO₂、SiO等の表面への密着力増強用とし て、一般によく使用されているが、通常は、洗浄 後の基板をシランカツプリング剤溶液に浸漬又は 塗布してから、レジストを塗布する場合が多い。 ここでは、フオトレジスト中に微量(0.01~0.5 %) のシランカツプリング剤(例えばシツプレー -1100〉を混入したものを直接基盤上に塗布する 方法をとつた。この結果レジストの密着力が向上 すると共に、パターン形成後の無電解メツキ膜の 密着力が向上した。また、この方法では、レジス トを露光する際、カブリを生じたためにレジスト 層が浮きかかつても、再度ベーキングすることに よりレジストの密着力がある程度再生した。

第1図~第5図は本発明をビデオデイスクに適 用した一実施例を示すものである。

まず第1A図に示すように、ガラス板1の表面 にAZ-1350からなるフオトレジスト層 2 を0.1~ 0.5μ m厚で一様に塗布する。このフオトレジス ト層の塗布に際じでは、シラジカツブリジグ剤 (例えばA-1100) を0.1%程度AZ-1350中に混 含有するフオトレジスト層2を形成する。次いで 従来公知の方法により、レーザー光3をフォトレ ジスト層 2 に対し順次所定パターンに照射し、こ の照射部分のフォトレジストを蒸発させて記録情

8

報となるピット 4 を形成(カツテイング)する。 なおこのピットは他の方法で形成してよく、例え ば、レーザー光3が照射されたフォトレジスト部 分を現像処理によりエッチング除去したり、或い はピット形成部分以外にレーザー光を照射して非 5 照射部分を現像処理によりエッチング除去して も、第1 A図に示すパターンのピット 4 を形成す ることができる。

こうして原盤を製作してから、第1B図に示す ように、ピツト4を含むフオトレジスト層2表面10 に無電解メツキ層5を一様に形成する。このメツ キを行なうには、例えば硫酸ニツケル、次亜リン 酸ナトリウム、酢酸塩等からなる酸性メツキ浴に ガラス板 1 表面を浸漬すればよいが、このメツキ 前に第4図に拡大誇示するように表面にPd粒子 15 6を付着させておく。既述したように、フオトレ ジスト層2中に混入させたシランカップリング剤 はガラス板1表面と結合すると共に、フォトレジ ストともなじみがよく、またPdとキレートによ つて結合する。従つて第4図の状態で無電解メツ20 キを施すと、フォトレジスト層2はガラス板1に 強固に密着した状態で、メツキ層 5 がPd粒子 6 と結合したシランカツプリング剤を介してフォト レンスト層6表面に強固に付着することになる。 なおピツト4部分にも僅かではあるがシランカツ 25 プリング剤が残つていると思われるので、ピツト 4にも無電解メツキ層5が強固に付着する。

次いで第1B図の原盤の表面に通常の電気メツ との間に、ポリ塩化ビニル等のビデオデイスク材 キ (Niメツキ)を施し、このメツキ層を剝離し 料層19を挾んだ状態で、矢印20,21方向か て第1C図に示すマスター盤7を製作する。この 30 ら圧力を加えて材料層19をプレスする。この結 マスター盤の表面には、上述のピツト4に対応し 果、第3B図に示すように、一方の面にスタンパ た凸部8が形成される。 ー12の凸部11に対応したピツト22が形成さ

次いで第1D図に示すように、マスター盤7の れ、他方の面がスタンパー120 表面に通常の電気メツキ (Niメツキ) を施し、 た平坦面23 (鏡面) に形成され 凸部8に対応したピツト9を有するマザー盤10 35 をプレス成形することができる。を剝離する。ピツト9は従つて原盤のピツト4に このレプリカ24は従つて当初 正確に対応したものとなる。このマザー盤10は ト4 (第1B図) に正確に対応したものとなる。このマザー盤10は ト4 (第1B図) に正確に対応してのピット22を有すると共に

次いで第1E図に示すように、マザー盤10の 表面に通常の電気メッキ (Niメッキ) を施し、40 ピット9に対応した凸部11を有するスタンパー 12を剝離する。このスタンパーもマザー盤10 から多数製作しておき、次のレプリカの製作に使 用する。

他方、レプリカのプレス成形のために使用する 鏡面スタンパーを製作するには、まず第2A図に 示すガラス板13の表面に、第5図に拡大誇示 るようにシランカツプリング剤層14を付着させ め、Pd粒子15を付着させておく。シランカツ プリング剤層14は、ガラス板13の表面を容別 に付着する。この結果、シランカツプリング剤が ガラス板13表面と強固に結合すると共に、Pd ともキレートによつて結合することになるから、 この状態で上述と同様に無電解メツキを施せば、 第2B図に示すようにシランカツプリング剤を介 してガラス板13と強固に密着した無電解メツキ 層16を形成することができる。

次いでガラス板13の表面に通常の電気メツキ(Niメツキ)を施して、第2C図に示すように平坦な表面を有するスタンパー17を剝離する。このスタンパーは鏡面スタンパーと称されるものであつて、無電解メツキ層16の平坦な表面に対応した鏡面18を有している。なお第2B図の状態においてまず電気メツキによつてマザーを作り、これから鏡面スタンパーを多数製作してもよい。

以上のようにして製作されたスタンパー12 (第1E図)及び鏡面スタンパー17 (第2C図)を使用してレプリカを製作する。即ち第3A図に示すように、スタンパー12の情報記録面、即ち凸部11側表面とスタンパー12の鏡面18との間に、ポリ塩化ビニル等のビデオデイスク材料層19を挟んだ状態で、矢印20,21方向から圧力を加えて材料層19をプレスする。この結果、第3B図に示すように、一方の面にスタンパー12の凸部11に対応したピット22が形成され、他方の面がスタンパー12の面18に対応した平坦面23 (鏡面)に形成されたレプリカ24をプレス成形することができる。

このレプリカ24は従つて当初の原盤1のピット4(第1B図)に正確に対応した記録情報としてのピット22を有すると共にいこのピット22 側とは反対側に極めてきれいな平坦面23を有することになる。このレプリカ24に対して所定の処理、例えばピット22側表面へのAl薄膜(反射膜)の蒸着を施してビデオデイスクを完成するが、情報読取りに際しては平坦面23側からレーザー光25を照射することになる。この場合、デ

10

イスクの光入射側は平坦面23に形成されている から、場所的にみてレーザー光25がほぼ均一に 情報記録面へ到達し、この面で反射後にほぼ均--に逆の光路をたどつて進行することになり、記録 とができる。

以上説明したように、シランカツプリング剤の 使用によつて、メツキの付きにくい非常に滑らか なガラス板や、ガラス板と密着力が弱いとされて いたフオトレジスト上に、無電解メツキ層を強力 10 に密着させることができ、電気メツキ等の処理に 充分耐え得るものとすることができる。特に、ガ ラス板に対する無電解メツキによつて鏡面スタン パーの製作が可能となり、またフォトレジストに 対する無電解メツキによつて情報記録面を有する 15 ンパーによつてレブリカをプレス成形するときの スタンパーを精度良く製作できる。また無電解メ ツキの前処理として、従来のようにエツチング等 の粗面化や特別な装置の使用が不要であり、シラ ンカツプリング剤の単一水溶液にガラス板を短時 間浸漬するか、或いはフオトレジスト中に予めシ 20 ランカツプリング剤を混入させておくだけでよい から、簡単な操作にして低コストで精度良くビデ オデイスクを製作できる。

以上述べた本発明の実施例は更に変形が可能で あることが理解されよう。例えば、第1B図及び 25 スター盤、10はマザー盤、12はスタンパー、 第4図に示す工程において、シランカツブリング 剤をフオトレジストに混入するだけでなく、フォ トレジストの表面をシランカツプリング剤の溶液 に浸漬してその表面にシランカツブリング剤を付

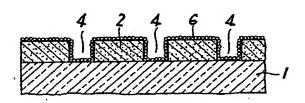
着せしめるようにしてもよい。また無電解メツキ 層、電気メツキ層、レプリカの材質、及び情報記 録面の形状等を種々に変更してもよい。また無電 解メツキに際する活性化段階での触媒金属として 情報を精度良く再生でき、S/N比を高くするこ 5 Pd以外のものも使用可能である。なお本発明は ビデオデイスク以外の情報記録媒体にも適用でき るし、また単なる無電解メツキを施す場合にも適 用できる。

図面の簡単な説明

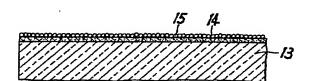
図面は本発明をビデオデイスクに適用した一実 施例を示すものであつて、第1A図~第1E図は 情報記録面を有するスタンパーの製作を工程順に 示す断面図、第2A図~第2C図は鏡面スタンパ 一の製作を工程順に示す断面図、第3A図はスタ 断面図、第3B図はプレス成形されたレプリカの 断面図、第4図は第1B図の無電解メツキ前に表 面に触媒金属粒子を付着せしめた状態を誇張して 示す拡大断面図、第5図は第2B図の無電解メツ キ前に表面に触媒金属を付着せしめた状態を誇張 して示す拡大断面図である。

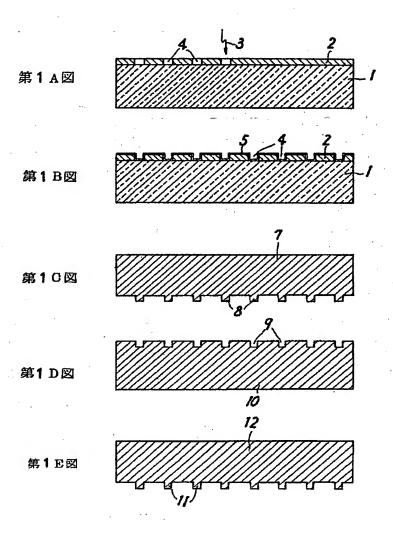
なお図面に用いられている符号において、1, 13はガラス板、2はフオトレジスト、5, 16 は無電解メツキ層、6, 15はPd粒子、7はマ 14はシランカツプリング剤層、17は鏡面スタ ンパー、19はビデオデイスク材料層、22はピ ツト、24はレプリカである。

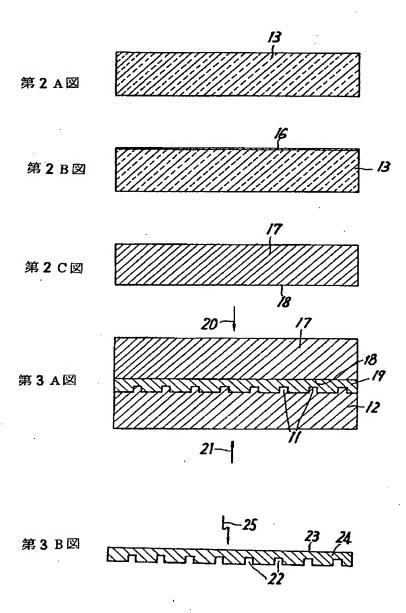
第4図



第5図







This page Blank (uspto)